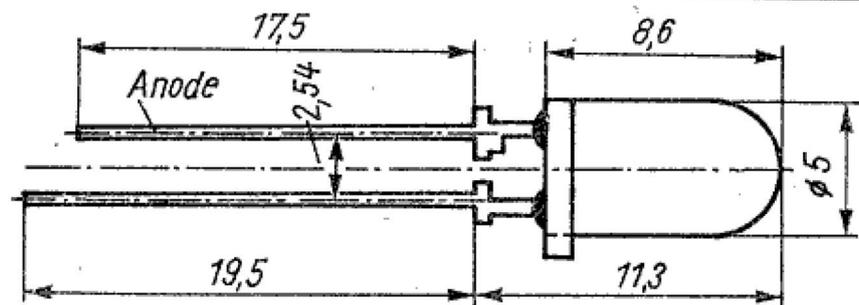


VQ 125

Infrarotemitterdiode auf GaAs-Basis in einer rauchfarbenen 5-mm-Durchmesser-Allplast-Linsenverkapung.

Die Diode weist einen hohen Strahlungsfluß auf und ist für Impulsbetrieb geeignet. Ihr Emissionsbereich ist gut an den spektralen Empfindlichkeitsbereich von Si-Fotoempfängern angepaßt.

Bauform 17



Kennwerte	bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$	min.	typ.	max.	
Durchlaßgleichspannung	U_F				
bei $I_F = 50\text{ mA}$		—	1,3	1,5	V
bei $I_F = 100\text{ mA}$		—	1,4	1,7	V
Strahlungsleistung					
bei $I_F = 50\text{ mA}$					
VQ 125 A	Φ_e	2,4		5	mW
VQ 125 B	Φ_e	3,6		—	mW
Sperrgleichstrom					
bei $U_R = 3\text{ V}$	I_R	—		0	μA
Wellenlänge des Maximums der spektr. Emission					
bei $I_F = 50\text{ mA}$	λ_{max}	900		980	nm
Spektrale Strahlungsbandbreite	$\Delta\lambda_{0,5}$	—		75	nm
Öffnungswinkel	Θ	40	55	—	$^\circ$
Schaltzeiten					
bei $I_{\text{FRM}} = 50\text{ mA}$					
Impulsanstiegszeit	t_r, t_f	—		2	μs
Grenzwerte					
Durchlaßgleichstrom					
bei $\vartheta_a = -40\text{ bis }+25^\circ\text{C}$	I_F	—		100	mA
Spitzendurchlaßstrom periodischer					
bei $\vartheta_a = -40\text{ bis }+25^\circ\text{C}$	FRM	—		200	mA
Spitzendurchlaßstrom					
bei $\vartheta_a = -40\text{ bis }+25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	—		2,5	A
Sperrgleichspannung					
bei $\vartheta_a = -40\text{ bis }+85^\circ\text{C}$	U_R	—		5	V
Betriebstemperatur	ϑ_a	-40		+85	$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperatur	ϑ_{stg}	-55		+100	$^\circ\text{C}$